QUESTにおけるRFの高磁場側入射における加熱特性について Heating characteristics of high field side RF injection in QUEST

村上貴洋¹,小島信一郎¹,花田和明²,Hatem ELSERAFY³,出射浩²,井戸毅²,池添竜也²,長 谷川真²,恩地拓己²,黒田賢剛²,稲垣滋²,河野香¹,福山雅治¹,木谷彰宏¹,Yi PENG⁴,大澤 佑規⁴,江尻晶⁴

Takahiro MURAKAMI¹, Shinichiro KOJIMA¹, Kazuaki HANADA², Hatem ELSELAFY³, Hiroshi IDEI², *et al.*

¹九大総理工,²九大応力研,³(株)日立製作所,⁴東大新領域 ¹IGSES, Kyushu Univ., ²RIAM, Kyushu Univ., ³Hitachi, Ltd., ⁴GSFS, Univ. of Tokyo

1. 序論

球状トカマク(STs)は高誘電率であるため,通 常用いられる低域混成波や電子サイクロトロ ン波(ECW)では有効に加熱することが難し い.一方,高磁場側(HFS)から高周波を入射す ればカットオフ密度のない電子バーンシュタ イン波(EBW)励起による加熱が期待できる. また低磁場(LFS)入射の場合と異なり,HFS入 射X-mode ECWが高域混成共鳴(UHR)で直接 モード変換するため,プラズマ立ち上げ等の 低密度でも使用可能である.このEBWへのモ ード変換と加熱効率を調べるため,球状トカ マク型プラズマ実験装置「QUEST」を用いて, HFSとLFSからXモードのRFを入射した時の プラズマの電子温度·密度を計測し,入射パ ワーの吸収機構や加熱効率について調べた.

2. 実験方法

HFS 入射用と LFS 入射用の導波管を設置し て[1, 2], HFS と LFS から 8.2 GHz の高周波 (RF)を 30 ms 入射し, QUEST の赤道面上 でトムソン散乱計測および可動プローブ計測 を行った.

3. 実験結果

図1にHFSおよびLFS入射時の密度と温度の 空間分布を示す.HFS入射時とLFS入射時の密 度に約4倍の差があり,HFS入射では入射RF の周波数でのプラズマカットオフを超える密 度に達している.また,EBWの励起を示すパ ラメトリック崩壊不安定性信号が確認済であ るため,EBWによって加熱していると考えら れる.電子温度のピークはHFS入射では R=600 mm,LFS入射ではR=500 mmであった. LFS入射ではECR層近傍で加熱・密度上昇が起 こっているため,LFS入射ではサイクロトロン 吸収であると考えられる.しかし,HFS入射の 場合にはUHR層近傍であり,ドップラーシフ トした電子のサイクロトロン共鳴加熱でも, R=500~700 mmで衝突吸収率が1%以下であることから衝突吸収でも説明できず, N_{\parallel} 成分の存在次第ではランダウ吸収の可能性が示唆される[3].

- 4. まとめ
 - 高周波の高磁場・低磁場側入射を実験的に比 較し,高磁場入射時にはプラズマ遮断密度を 超える密度に達していることを確認した.加 熱位置は低磁場入射ではサイクロトロン共鳴 層,高磁場入射では高域混成共鳴近傍で,加 熱機構が異なる可能性が示唆される結果を得 た.



 図1 上図は HFS 入射時と LFS 入射時の電子 温度,下図は HFS と LFS 電子密度の空間 分布. プローブ計測された電子密度は トムソン散乱計測により構成されてい る. 黄緑線は ECR 層,赤線は 8.2 GHz 周 波数の O モードカットオフ密度を示す. ECR 層は 440 mm の位置に設定した.

参考文献

- [1] H. Elserafy *et al.*, 2020 Plasma Phys. Control. Fusion 62, 035018
- [2] S. Kojima *et al.*, 2020 Plasma and Fusion Res. 15, 2402063
- [3] A. I. Anisimov et al., 1973 Sov Phys.–Tech. Phys. 18, 459